

- [16] Шульга Ю.М., Моравский А.П., Лобач А.С., Рубцов В.И. // Письма в ЖЭТФ. 1992. Т. 55. № 2. С. 137–140.  
[17] Hansen P.L., Fallon P.J., Kratschmer W. // Chem. Phys. Lett. 1991. V. 181. N 4. P. 367–370.  
[18] Dravid V.P., Lin S., Kappes M.M. // Chem. Phys. Lett. 1991. V. 185. N 1,2. P. 75–81.  
[19] Kratschmer W., Lamb L.D., Fostirooulos K., Huffman D.R. // Nature. 1990. V. 347. P. 354–356.  
[20] Pfleider J.P., Fink J., Weber W. et al. // Phys. Rev. 1984. V. B30. N 3. P. 1155–1163.  
[21] Шульга Ю.М., Рубцов В.И., Дулинец Ю.Ч. и др. // Поверхность. 1989. № 12. С. 110–117.

Институт химической физики РАН  
Черноголовка  
Московская обл.

Поступило в Редакцию  
2 ноября 1992 г.

© Физика твердого тела, том 35, № 4, 1993  
*Solid State Physics, vol. 35, N 4, 1993*

## ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ НАКАЧКА МАГНИТНЫХ ВОЗБУЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ МОДУЛЯЦИИ ИХ СПЕКТРА

*В.Л.Сафонов*

Мощным инструментом исследования спиновых волн и магнитоупротягих волн в магнетиках служит метод параметрического резонанса [1–3]. Переменное магнитное поле  $h \cos \omega_p = t$  при достижении критической амплитуды  $h_{c0} = \gamma_k / V_k$  ( $\gamma_k$  — скорость релаксации,  $V_k$  — коэффициент связи волн с полем накачки) вызывает экспоненциальный рост числа пар волн половинной частоты с  $\omega_k = \omega_{-k} = \omega_p / 2$ . Порог  $h_c$  указанного процесса возрастает, если условие резонанса нарушается [4,5] модуляцией спектра волн либо от внешнего источника, либо за счет магнитных флуктуаций, нарастающих в образце по мере приближения к точке фазового перехода.

Ранее в [6] нами был проведен расчет  $h_c$  в условиях шумовой и гармонической ( $H_m \cos \omega_m$ ) модуляций. Однако, результаты [6] ограничены снизу областью частот, меньших  $\gamma_k$ , в которой пакет параметрических волн начинает “отслеживать” изменения спектра [7,8]. Поскольку реакция параметрической системы на низкочастотное воздействие представляет самостоятельный интерес, в настоящем сообщении мы обобщим выражение для  $h_c$  на эту область, кроме того, приведем формулы, необходимые для расчета свойств запорогового состояния системы в условиях шумовой модуляции.

Будем исходить из системы уравнений модифицированной  $S$ -теории [8], записанной в виде

$$\frac{d}{d\tau} \theta + b \sin \theta = \Delta(\tau) - \langle \Delta(\tau) \rangle - r_s N, \quad (1a)$$

$$\frac{d}{d\tau} I_n(N) = b \cos \theta - 1 - \eta N. \quad (1b)$$

Здесь  $\theta$  — угол расфазировки между вынужденными колебаниями сре-  
ды и полем накачки;  $N$  — число параметрических волн на одну ячей-  
ку;  $b = h/h_{c0}$ ;  $\tau = 2\gamma_k t$ ;  $\eta$  — коэффициент нелинейного затухания;  $\Delta \equiv$   
 $\equiv [\omega_p/2 - \tilde{\omega}_k(\tau)]/\gamma_k$ ;  $\tilde{\omega}_k = \omega_k + \gamma_k [2r_T N + a \cos \Omega \tau + \xi(\tau)]$  — перенормиро-  
ванный спектр;  $r_s \equiv S_k/\gamma_k$ ;  $r_T \equiv T_k/\gamma_k$ ;  $S_k, T_k$  — коэффициенты нелинейно-  
го волнового взаимодействия;  $\Omega \equiv \omega_m/2\gamma_k$ ;  $a \equiv V_k H_m/\gamma_k$ ;  $V_k$  — эффектив-  
ный коэффициент связи возбуждаемых волн с полем модуляции. Предпо-  
лагаем, что случайный процесс  $\xi(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \xi_{\omega} \exp(i\omega t) d\omega$  имеет равное ну-  
лю среднее и известный спектр шума  $G(\omega) = \xi_{\omega} \xi_{-\omega}$ , характерная область  
частот которого много ниже частоты накачки. Угловые скобки в (1a)  
означают естественное предположение о том, что с полем накачки лучше  
всего связан “центр тяжести” пакета параметрических волн [8]. Система  
реагирует на отклонения от интегральных параметров, сформированных  
модами, находящимися в точном резонансе с накачкой и вышедшими из  
него. Мы ограничимся простейшей моделью с

$$\langle f(\tau) \rangle \equiv (1/\tau_0) \int_0^{\infty} f(\tau - \tau) \exp(-\tau_1/\tau_0) d\tau_1,$$

где  $\tau_0 \equiv 2\gamma_k t_0$ ,  $t_0$  — характерное время подстройки возбужденных волн  
под внешнее воздействие.

1) При расчете порога параметрического резонанса членами  $\sim N$  в  
правых частях (1a), (1б) можно пренебречь. Тогда для малых отклонений  
фазы из (1a) имеем (здесь  $b \equiv h_c/h_{c0}$ )

$$\theta = \theta_1 + A \cos \Omega \tau + B \sin \Omega \tau, \quad (2)$$

$$A = \frac{(\Omega \tau_0)^2}{(\Omega \tau_0)^2 + 1} (1 - 1/b\tau_0) ab / (\Omega^2 + b^2),$$

$$B = \frac{(\Omega \tau_0)^2}{(\Omega \tau_0)^2 + 1} (1 - b/\tau_0 \Omega^2) a \Omega / (\Omega^2 + b),$$

$$\theta_1 = \exp(-b\tau) \int_{-\infty}^{\infty} \xi_{\omega} \frac{\exp[(b+i\omega)t]}{b+i\omega} \left( \frac{i\omega \tau_0}{i\omega \tau_0 + 1} \right) d\omega.$$

Условие на порог следует из (1б)

$$b = 1/\overline{\cos \theta} \simeq 1/(1 - \frac{1}{2}\bar{\theta}^2), \quad (3)$$

где

$$\bar{f} \equiv \lim_{T \rightarrow \infty} \left[ \frac{1}{2T} \int_{-T}^T f(\tau) d\tau \right].$$

Подставляя (2) в (3), получаем

$$b = \left\{ 1 - \frac{a^2}{4(\Omega^2 + b^2)} \frac{(\Omega \tau_0)^2}{(\Omega \tau_0)^2 + 1} - \right.$$

$$-\frac{\pi}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{G(\omega)}{\omega^2 + b^2} \frac{(\omega\tau_0)^2}{(\omega\tau_0)^2 + 1} d\omega \Biggr\}^{-1}. \quad (4)$$

При  $\tau_0 \rightarrow \infty$  эта формула сводится к аналогичной из работы [6].

Перепишем уравнение (4) для случая только шумовой модуляции с прямоугольным спектром шума,  $G(\omega) = G_0$  при  $|\omega| \geq \omega_*$  и  $G(\omega) = 0$  при  $|\omega| < \omega_*$ , где  $\omega_*$  — частота края. В результате имеем

$$b = \left\{ 1 - \frac{\pi G_0 \tau_0}{(b\tau_0)^2 - 1} [b\tau_0 \operatorname{arctg}(\omega_*/b) - \operatorname{arctg}(\omega_*\tau_0)] \right\}^{-1}. \quad (5)$$

При  $\omega_* \gg b$ ,  $\tau_0^{-1}$  и  $G_0 = 2D/\pi^2\gamma_k$ , где  $D$  — спектральная плотность шума, получаем

$$h_c V_k = \frac{1}{2} \left\{ \gamma_k + D - 1/2t_0 + [( \gamma_k + D + 1/2t_0 )^2 - 2D/t_0]^{1/2} \right\}. \quad (6)$$

При  $t_0 \gg (2\gamma_k)^{-1}$  и  $t_0 \ll (2D)^{-1}$ ,  $(2\gamma_k)^{-1}$  шумовая модуляция аддитивным образом увеличивает порог параметрического резонанса.

2) При анализе запорогового поведения системы (1a), (1b) мы ограничимся случаем, когда отклонения  $\delta\theta$  и  $\delta N$ , вызванные модулирующим воздействием, невелики по сравнению со значениями  $\theta_0$  и  $N_0$  в стационарном состоянии. Тогда из линеаризованных по  $\delta\theta$  и  $\delta N$  уравнений (1a), (1b) следует

$$\delta\theta = \int_{-\infty}^{\infty} \delta\theta_\omega \exp(i\omega\tau) d\omega, \quad \delta N = \int_{-\infty}^{\infty} \delta N_\omega \exp(i\omega\tau) d\omega,$$

$$\delta\theta_\omega = (i\omega + \eta N_0) C_\omega / \det, \quad \delta N_\omega = -N_0 b \sin\theta_0 C_\omega / \det, \quad (7)$$

$$C_\omega = \xi_\omega \frac{i\omega\tau_0}{i\omega\tau_0 + 1}, \quad b \sin\theta_0 = -r_s N_0, \quad b \cos\theta_0 = 1 + \eta N_0,$$

$$\det = (i\omega + b \cos\theta_0)(i\omega + \eta N_0) - N_0 b \sin\theta_0 (r_s + 2r_T) \frac{i\omega\tau_0}{i\omega\tau_0 + 1}.$$

При  $\omega \rightarrow \infty$  имеем  $\delta N_\omega \propto \xi_\omega/\omega^2$  и  $\delta N_\omega \propto \omega\xi_\omega$  при  $\omega \rightarrow 0$ .

Используя формулы (7), нетрудно рассчитать, например, модуляционный отклик или нелинейную восприимчивость параметрической системы. Явный вид этих выражений достаточно громоздок, поэтому их детальный анализ имеет смысл проводить в работе, непосредственно связанной с экспериментом.

### Список литературы

- [1] Львов В.С. Нелинейные спиновые волны. М.: Наука, 1987.
- [2] Андриенко А.В., Поддъяков Л.В. // ЖЭТФ. 1989. Т.95. № 6. С.2117–2124.
- [3] Андриенко А.В., Поддъяков Л.В., Сафонов В.Л. // ЖЭТФ. 1992. Т.101. № 3. С.1083–1099.
- [4] Suhl H. // Phys.Rev.Lett. 1961. V.6. N 4. P.174–176.
- [5] Зауткин В.В., Львов В.С., Орел Б.И., Старобинец С.С. // ЖЭТФ. 1977. Т.72. № 1. С.272–284.

- [6] Сафонов В.Л. // ФТТ. 1992. Т.34. № 1. С.304–306.  
[7] Андриенко А.В., Ожогин В.И., Сафонов В.Л., Якубовский А.Ю. // ЖЭТФ. 1985. Т.89. № 6. С.2164–2173.  
[8] Андриенко А.В., Сафонов В.Л., Якубовский А.Ю. // ЖЭТФ. 1987. Т.93. № 3. С.907–917.

Институт атомной энергии  
им. И.В. Курчатова  
Москва

Поступило в Редакцию  
4 ноября 1992 г.

© Физика твердого тела, том 35, № 4, 1993  
Solid State Physics, vol. 35, N 4, 1993

## ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСИ Mg НА КИНЕТИКУ НЕСТАЦИОНАРНОГО ФОТООТКЛИКА КРИСТАЛЛОВ NIOBATA ЛИТИЯ, ЛЕГИРОВАННОГО ИОНАМИ Fe

Е.Л.Лебедева

Известно, что легирование является способом управления фотопрерывательными свойствами кристаллов ниобата лития. Так, примесь  $Fe^{+3}$  увеличивает фотопрерывательную (ФР) чувствительность, а примесь более 4.5 мол.% Mg значительно ее уменьшает [1,2]. Для выяснения влияния примеси Mg на ФР эффект в [2] изучались фотогальванический эффект (ФГЭ) и фотопроводимость в стационарном режиме возбуждения. Показано, что легирование Mg не оказывает влияния на ФГЭ. Уменьшение ФР эффекта при легировании Mg авторы связывают с возрастанием фотопроводимости.

В настоящей работе исследовался нестационарный фотоотклик кристаллов  $LiNbO_3:Fe$  0.05 мол.% и  $LiNbO_3:Fe$  0.05 мол.% Mg 5 мол.%. Кристаллы выращивались из конгруэнтного расплава методом Чохральского.  $LiNbO_3:Fe$ , Mg выращивался из шихты такого же состава, что и  $LiNbO_3:Fe$ , с добавлением  $MgO$ . Источником излучения служили первая (1.06 мкм) и вторая гармоники (0.53 мкм) лазера на АИГ:  $Nd^{3+}$ . Длительность лазерного импульса 15 нс, частота повторения импульсов 12.5 Гц, интенсивность падающего излучения до  $10^8$  Вт/см<sup>2</sup>. Кристаллы вырезались вдоль кристаллофизических осей  $x$ ,  $y$ ,  $z$ . Фотоотклик регистрировался конденсаторным методом. Временное разрешение регистрирующего устройства  $10^{-9}$  с. Измерялась импульсная разность потенциалов, возникающая на обкладках конденсатора с исследуемым кристаллом вдоль оси  $z$ , которая индуцируется поляризованной лазерным излучением областью кристалла. Исследовались зависимости формы фотоотклика от интенсивности и длины волн падающего излучения, а также от зарядового состояния примеси Fe. Изменение зарядового состояния примеси Fe достигалось отжигом в вакууме и атмосфере кислорода. Измерения проводились при комнатной температуре и температуре жидкого азота.

На длине волны 0.53 мкм передний фронт фотоотклика кристалла нарастал по интегралу от лазерного импульса (рис. 1) с последующим